



CFY19-18 FET Transistor GaAs N-FET Transistor



8,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 8-892-03870

CFY19-18 N-FET Transistor / GaAs FET / GaAs N-FET Transistor / preferred for use in microwave applications / MICROWAVE Transistor / Rauscharm hoher Verstärkung Ionenimplantierte Planarstruktur vergoldete Metallisierung / Für Oszillatoren / Für Antennenverstärker von UHF bis 6 GHz

CFY19-18 N-FET Transistor

- GaAs FET / GaAs N-FET Transistor
- preferred for use in microwave applications / MICROWAVE RADIO Transistor
- Rauscharm hoher Verstärkung Ionenimplantierte Planarstruktur vergoldete Metallisierung
- Für Oszillatoren / Für Antennenverstärker von UHF bis 6 GHz
- Technische Daten (max)
- Vdc : 5Volt / Vgs : -05...+0,5V / Ids : 80-100mA / Ptot: 300mW /
- F: bis 6Ghz / Ga <9,5dB
- Gehäuse : Cerec-XF
- solange Vorrat reicht (abgekündigtes ERsatzteil)